BL-6A/2018G077

外部電場で誘起されるポリマー結合金ナノロッドの集合構造形成 および緩和過程に対する時間分解 SAXS 測定

Time-resolved SAXS study on the structural change of polymer-capped gold nanorods induced by an external electric field

日野和之^{1,*}, 深川記壮¹, 山口佳大¹, 畠山義清²
¹愛知教育大学教育学部, 〒448-8542 愛知県刈谷市井ヶ谷町広沢 1
²群馬大院理工, 〒376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1
Kazuyuki HINO^{1,*}, Toshiaki FUKAGAWA¹, Yoshihiro YAMAGUCHI¹, and Yoshikiyo HATAKEYAMA²
¹Department of Chemistry, Faculty of Education, Aichi University of Education, 1 Hirosawa, Igaya, Kariya, 448-8542, Japan
²Graduate School of Science and Technology, Gunma University, 1-5-1 Tenjincho, Kiryu, 376-8515, Japan

1 <u>はじめに</u>

我々は、ポリスチレンチオール(ポリマーチオー ルと略称)が結合した金ナノロッドに対して、外部 電場の印加によるその集合構造の変化を吸収スペク トル、ラマン散乱および小角 X 線散乱(SAXS)測 定により検討している。金ナノロッドに閉じ込めら れた自由電子の集団振動による共鳴励起は、ナノロ ッド表面近傍において電場増強が著しく、その集合 構造を制御できれば、さらなる電場増強が可能にな る。

我々はこれまでに、ポリマー結合金ナノロッドに 対して、電場印加による吸収スペクトルの変化、 SAXS 強度の減少および集合構造の変化に対応する 距離分布関数の形状の変化を確認した。アスペクト 比(AR,長軸の長さ/短軸の長さ)2,4,6を有す る比較的サイズが大きい金ナノロッド(短軸~50 nm,長軸~100 nm)を対象に研究を進めている。注 目すべき点は、強度の大きい電場(2.5~5.0 V/μm) を印加することでナノロッドがスメクチック、テト ラゴナルおよびへキサゴナル集合構造を形成するこ とである。しかしながら、集合構造の遷移過程およ びその形成における閾電場強度は解明できておらず、 電場強度をより細かく設定した測定が必要である。

本研究では、NaOL-CTAB 系で作製した金ナノロ ッドにポリマーを結合させた試料のトルエン溶液に 対して、外部電場を印加しながら吸収スペクトル、 ラマン散乱、および SAXS 測定を行い、電場誘起に よる集合構造の遷移を調べることを目的とする。

2 実験

〈ナノロッド〉NaOL-CTAB 系の 2 成分界面活性 剤と規定量の AgNO₃の存在下,HAuCl₄を穏やかに 還元し,そこに規定量の濃 HCl を加えた。それから アスコルビン酸を加えて激しく撹拌した後にシード 溶液を加えて金ナノロッドを作製した。金ナノロッ ドの AR は, 界面活性剤の混合比, AgNO₃, 濃 HCl, シード溶液の量を調整することで制御した[1, 2]。

〈ポリマー置換〉遠心精製した金ナノロッドの水溶 液とポリマーチオール(平均分子量 Mn = 53000)の THF 溶液を混合し撹拌させた。生じた沈殿を回収し, 過剰のポリマーチオールを洗浄した後,減圧乾燥し た。 〈電場印加〉試料をトルエンに溶解した溶液を 電場セルに入れ、直流電圧を0Vから2400Vまで印 加して, 吸収スペクトル, ラマン散乱および SAXS プロファイルの変化を観測した。電場セル:電極間 間隔 600 µm, 溶液層厚み 300 µm。〈構造因子〉各 電場強度で得られた SAXS プロファイルを 0 V で得 られたそれで割り算することによって構造因子 S(q) を得た。構造因子はナノロッド間に干渉が見られる 場合に確認でき, 散乱パターンを解析することによ り集合構造の特定が可能となる。干渉が存在しない 場合,構造因子 S(q) = 1 を示し,散乱強度は形状因 子等に依存する。

3 <u>結果および考察</u>

図1にAR4ポリマー結合金ナノロッドのSAXSプ ロファイルを示す。小角分解能は $q = 0.0497 \text{ nm}^{-1}$ で あった。電場強度を上げると 1800 V までは SAXS 強度が減少したが、2000、2200、2400 V 印加時に 4 つのピークを観測した。より詳細な解析のため、各 電場強度の構造因子を取り出した(図 2)。1800 V までの電場強度ではS(q)の値は1をとるが、2000、 2200、2400 V 印加時に集合構造の形成に起因する *S* (q)の変化を確認した。この 4 つのピークは金ナノロ ッドがスメクチック集合構造を形成したときの散乱 パターンと一致した($q_1:q_2:q_3:q_4=1:2:3:4$)。 注目すべき点は、電場強度を大きくすると 4 つのピ ークが高 q 側へシフトしたことである。このことか ら、強い電場強度でナノロッドがより密なスメクチ ック集合構造を形成していることが分かった。 〈100〉面の干渉に起因する q_1 の値が 2400 V 印加時 に 0.0526 nm⁻¹ であることから,ナノロッドの中心 間の距離が 119 nm の面間隔で配列したスメクチッ ク集合構造を形成していることが分かった。

また、同じ試料のラマン散乱測定から、より強度 の大きな電場印加時に溶媒である四塩化炭素の変角 振動に帰属される、445 cm⁻¹ピークの増大を観測し た(図3)。このことから、より強い電場強度でナ ノロッドは密な集合構造を形成するだけでなく、ロ ッド間に局在する電場をより増強させることが分か った。今後、電極間距離が小さい密閉型セルの開発 を進め、より詳細な集合構造の追跡および電場誘起 による金ナノロッドの光学特性の制御を追究する。



Fig. 1. SAXS profiles of AR4 nanorods



Fig. 2. Structural factor of AR4 nanorods



Fig. 3. SERS spectra of carbon tetrachloride nearby AR4 nanorod sample

4 <u>まとめ</u>

AR4 ポリマー結合金ナノロッドに外部電場を印加 した。SAXS プロファイルから構造因子を取り出し 解析したところ,スメクチック型集合構造を形成す ることが分かった。電場強度を大きくすると,集合 構造がより密になり,それと対応して,近傍(溶媒) 分子のラマン散乱強度が増強することが分かった。

謝辞

本研究の一部は、科研費(No. 23710127, No. 16K04865)の助成を受けて行われました。ここに感謝いたします。

参考文献

- [1] X. Ye, C. Zheng, J. Chen, Y. Gao, C. B. Murray, *Nano Lett.* **13**, 765 (2013).
- [2] I-C. Yao, C.-W. Chang, H.-W. Ko, H. Li, T.-C. Lu, J.-T. Chen, *RSC Adv.*, 6, 90786 (2016).

成果

- Toshiaki Fukagawa, Hiroaki Tanaka, Kouki Morikawa, Shunsuke Tanaka, Yoshikiyo Hatakeyama, and Kazuyuki Hino, Spatial Ordering of the Structure of Polymer-Capped Gold Nanorods under an External DC Electric Field, *J. Phys. Chem. Lett.* 2020, *11*, 2086–2091.
- * khino@auecc.aichi-edu.ac.jp